

第 6 回 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 個別討論会
テーマ『SiC デバイス特性に関連した欠陥評価』

主催： 社団法人 応用物理学会 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会

日時： 2011 年 7 月 29 日（金）

場所： 京都キャンパスプラザ 第一会議室

プログラム

10:30-10:35 「はじめに - 討論会のねらいと議論の進め方 - 」

伊藤久義（（独）日本原子力研究開発機構）

10:35-11:05 「国家プロジェクト『低炭素社会を実現する新材料パワー半導体プロジェクト』における、共通基盤評価技術の取り組み - 表面欠陥と電気特性/歩留まり/信頼性との紐付け - 」

北島 真（パナソニック(株)）

11:05-11:35 「転位欠陥の評価と分類」

浜田 信吉（（株）エコトロン）

< 休憩 >

11:50-12:20 「高品質 4H-SiC バルク結晶の溶液成長」

旦野 克典（トヨタ自動車（株））

12:20-12:50 「4H-SiC エピ成長における欠陥挙動の解析」

土田 秀一（電力中央研究所）

< 昼食 >

13:50-14:20 「高性能・高信頼 SiC MOS 特性の実現に向けた技術課題」

先崎 純寿（産業技術総合研究所）

14:20-14:50 「SiC のゲート酸化膜の信頼性に影響を及ぼすエピ表面欠陥について」

畠山 哲夫（産業技術総合研究所）

< 休憩 >

15:05-15:35 「SiC-MOS 界面欠陥の評価とその改善策」

渡部 平司（大阪大学）

15:35-16:05 「分光エリプソメトリによる SiC の酸化膜界面構造と酸化過程の観察」

土方 泰斗（埼玉大学）

16:05-16:30 「総合討論」

世話人： 畑山 智亮（奈良先端科学技術大学院大学）、

矢野 裕司（奈良先端科学技術大学院大学）

須田 淳（京都大学）